12. 3. 2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 3月14日

REC'D 29 APR 2004

PCT

Application Number:

特願2003-071028

WIPO

[ST. 10/C]:

[JP2003-071028]

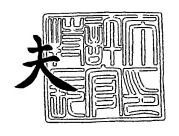
出 願 人
Applicant(s):

松下電器産業株式会社 独立行政法人理化学研究所

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 4月14日

今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

2000050002

【提出日】

平成15年 3月14日

・【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01J317/248

H01J 37/248

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

佐々木 雄一朗

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

水野 文二

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府茨木市美穂が丘10-1大阪大学内

【氏名】

畑中 吉治

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

片山 武司

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

渡辺環

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【特許出願人】

【識別番号】

000006792

【氏名又は名称】 理化学研究所

【代理人】

【識別番号】

100105647

【弁理士】

、【氏名又は名称】 小栗 昌平

【電話番号】

03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】

100105474

【弁理士】

【氏名又は名称】 本多 弘徳

【電話番号】

03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】

100108589

【弁理士】

【氏名又は名称】 市川 利光

【電話番号】

03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100115107

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 猛

【電話番号】

03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】

100090343

【弁理士】

【氏名又は名称】

栗宇 百合子

【電話番号】

03-5561-3990

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

092740

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0002926

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】ビーム電流測定装置およびこれを用いたビーム電流測定方法 【特許請求の範囲】

【請求項1】外部磁場遮蔽用の磁気遮蔽部と、前記磁気遮蔽部によって生成された遮蔽空間に配された磁場センサとを備え、測定すべきビーム電流が生成する磁場を前記磁場センサで測定するビーム電流測定装置であって、

前記磁場センサは、磁束-帰還電流変換係数が8×10-15 Wb/A以上であることを特徴とするビーム電流測定装置。

【請求項2】前記磁場センサは、磁束-帰還電流変換係数が2×10-12 Wb/A以下であることを特徴とする請求項1に記載のビーム電流測定装置。

【請求項3】前記磁場センサは、磁束-帰還電流変換係数が1×10-12 Wb/A以下であることを特徴とする請求項1または2に記載のビーム電流測定装置。

【請求項4】外部磁場遮蔽用の磁気遮蔽部と、前記磁気遮蔽部によって生成された遮蔽空間に配された磁場センサとを備え、測定すべきビーム電流が生成する磁場を前記磁場センサで測定するビーム電流測定装置であって、

前記磁場センサは、磁束感度が2×10-18 Wb/V以上であることを特徴とするビーム電流測定装置。

【請求項5】前記磁場センサは、磁気感度が5×10-15 Wb/V以下であることを特徴とする請求項4に記載のビーム電流測定装置。

【請求項6】前記磁場センサは、磁束感度が2×10-15 Wb/V以下であることを特徴とする請求項4または5に記載のビーム電流測定装置。

【請求項7】前記磁場センサは2個のジョセフソン接合を平行に配置した超伝導リング構造を有することを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載のビーム電流測定装置。

【請求項8】前記磁場センサは2個のジョセフソン接合を平行に配置した超伝導リング構造は高温超伝導体であることを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載のビーム電流測定装置。

【請求項9】前記磁場センサは、測定すべき磁束に感応するセンサ部を外部磁場から磁気遮蔽する磁気遮蔽部を具備したことを特徴とする請求項1乃至8のいず

れかに記載のビーム電流測定装置。

【請求項10】前記磁気遮蔽部は超伝導体からなることを特徴とする請求項9に 記載のビーム電流測定装置。

【請求項11】前記磁気遮蔽部は高温超伝導体からなることを特徴とする請求項 9に記載のビーム電流測定装置。

【請求項12】前記磁気遮蔽部はギャップを有することを特徴とする請求項10 または11に記載のビーム電流測定装置。

【請求項13】前記磁場センサは、測定すべき磁束に感応するセンサ部を外部電場から遮蔽する電場遮蔽部を具備したことを特徴とする請求項1乃至12のいずれかに記載のビーム電流測定装置。

【請求項14】前記磁気センサは、測定すべきビーム電流が生成する磁場を収集 する機構を具備したことを特徴とする請求項1乃至13のいずれかに記載のビー ム電流測定装置。

【請求項15】前記磁場を収集する機構は、軟磁性体コアに超伝導線を巻回した コイル、または表面を高温超伝導体でコーティングし、外周面には一部分のみを 高温超伝導体で構成したブリッジ部分を有する円筒であることを特徴とする請求 項14に記載のビーム電流測定装置。

【請求項16】請求項1乃至15のいずれかに記載のビーム電流測定装置を用い、イオン源または電子線源から被処理物表面に照射されるビームライン上に、前記ビーム電流測定装置の磁場センサを配置し、前記磁場センサの出力から、前記ビームラインのビーム電流値を測定するようにしたことを特徴とするビーム電流測定方法。

【請求項17】イオン源または電子線源を用いて生成されたビームに対し、請求項16に記載のビーム電流測定方法を用いてビーム電流を測定する測定工程と、

前記測定工程で得られた前記ビーム電流値を、前記イオン源または電子線源の . 制御パラメータに帰還する制御工程と、

前記制御工程で得られた制御パラメータを用いて制御されたビーム電流を被処 理物に照射する照射工程とを含むことを特徴とするビーム照射方法。

【請求項18】請求項1乃至15のいずれかに記載のビーム電流測定装置を備え

たビーム照射装置。

【請求項19】請求項1乃至15のいずれかに記載のビーム電流測定装置を具備 したイオン注入装置、電子ビーム露光装置、加速器を用いて製造したことを特徴 とする被処理物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ビーム電流測定装置およびこれを用いたビーム電流測定方法にかかり、特にイオンビームを遮断することなく、ビーム電流値を高精度で測定する装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

ビームを遮断することなく、イオンビームの電流値を高精度で測定する方法としては、従来、研究報告がなされている(非特許文献 1 参照)。この方法は、極めて高感度の磁場センサであるジョセフソン接合素子を用いたスクイッド(SQUID)と呼ばれるセンサを用いて、ビーム電流がつくる磁場を検出してビーム電流値を測定するものである。SQUIDとは 2 個のジョセフソン接合を平行に配置した超伝導リング構造を有し、この超伝導リングを貫通する磁束について磁束量子(2.07×10-15 Wb)を尺度に測定するものである。

[0003]

上記文献では、SQUIDは液体へリウム温度で動作する低温超伝導体を用いたものが使用されている。また、このビーム電流測定装置は、ビーム電流に対応した磁場を検知する検知部と、磁束を測定部に伝達する磁束伝達部と、伝達された磁束に感応する超伝導素子と超伝導素子を貫く磁束の変化を打ち消すように帰還電流を流す帰還コイルを有する測定部と、検知部と磁束伝達部と測定部をイオンビームが流れる空間を含む外部空間から磁気遮蔽する超伝導体からなるギャップを有する磁気遮蔽部によってその主要部が構成されている。

検知部は、軟磁性体のコアに超伝導線を巻回したコイルであって、ビーム電流 によって発生した磁場を軟磁性体コアで収集してコイルに超伝導電流を誘起する 。そしてこのコイルに誘起された超伝導電流は、SQUIDに隣接して配置したコイルまで伝達される。ビーム電流の変化に対応して、このコイルに流れる超伝導電流が変化することでSQUIDを貫く磁束量が変化しようとする。そこで、この検知部では、SQUIDを貫く磁束量が変化しないように、変化を打ち消すように帰還コイルに帰還電流を流す仕組みとなっている。この帰還電流がビーム電流値の変化に比例しており、帰還電流を測定することでビーム電流値の変化量を決定することができる。

[0004]

最近では高温超伝導体を用いたビーム電流値の測定方法が研究されている(非特許文献2参照)。この非特許文献2に開示されている方法によると、表面を高温超伝導体でコーティングした円筒を検知部として用いる。ただし、円筒の外周面には一部分だけが高温超伝導体のブリッジ部分を設けている。円筒の中央を買いたビーム電流は円筒の表面に表面遮蔽電流を誘起する。ここで、ブリッジ部分には表面遮蔽電流が集中する。そして、集中させた表面遮蔽電流がつくる磁束をSQUIDで測定する構成である。この方法において使用されているSQUIDは高温超伝導体を用いたものであり、液体窒素温度以上で動作させることができる。

[0005]

前者の低温超伝導のSQUIDを用いたビーム電流測定装置は数nA程度相当の雑音幅でビーム電流を測定することができる。

一方、後者の高温超伝導のSQUIDを用いたものは液体窒素または冷凍機だけで運転できるという利点があるが、雑音幅は数 μ A相当と大きいとされている(非特許文献 3 参照)。さらにゼロ点のドリフトも大きいため、数十秒以上の実際的な測定では $10\,\mu$ A相当程度以上のビーム電流しか測定できないという問題があった。

[0006]

他の非破壊型測定方法には直流変流器がある。しかし、雑音幅は数 μ A相当であり、ゼロ点のドリフトを考慮すると実際には 10μ A程度以下の測定は困難である。

[0007]

【非特許文献1】

超伝導装置およびその応用: Super Conducting Quantum Interference Devices and Their Applications (Walter de Gruyter, 1977) p. 311、IEEE TRANSACT IONS ON MAGNETICS, VOL. MAG-21, NO. 2, MARCH 1985、Proc. 5th European Particle Accelerator Conf., Sitges, 1996 (Institute of Physics, 1997) p. 1627、日本物理学会誌Vol. 54, No. 1, 1999

【非特許文献2】

アイトリプルイートランズアクションオンスーパーコンダクチビティ: IEEE TRA NSACTION ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, VOL. 11, NO. 1, MARCH 2001 p. 635 【非特許文献3】

アイトリプルイートランズアクションオンスーパーコンダクチビティ: IEEE TRA NSACTION ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, VOL. 11, NO. 1, MARCH 2001 p. 635

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

このように、低温超伝導のSQUIDを用いたビーム電流測定装置は、感度は高いが雑音に非常に敏感である。外部電磁場、機械的振動が雑音の原因になるため、シールドを強化すべく、種々の試みがなされており、シールドを強化すべく、外部電磁場、機械的振動を完全に遮断するために多くの研究者が鋭意研究を進めているのが現状である。

[0009]

しかしながら、外部電磁場、機械的振動をほぼ完全に近い状態に遮断しても、 耐雑音性に限界があることがわかった。そしてこれらの雑音によりSQUIDのロッ クが外れる(測定点がとぶ)ことがある。ロックが外れると測定の連続性が失わ れるので正確な測定ができないというのが深刻な問題であった。

[0010]

一方、高温超伝導のSQUIDを用いたビーム電流測定装置は感度が小さくゼロ点のドリフトも大きいので実際には 10μ A相当程度以上のビーム電流しか測定できなかった。ゼロ点のドリフトを無視できる短時間の測定でも雑音幅は数 μ Aであり、それより微小なビーム電流の測定は困難であった。

また、他の非破壊型測定方法としては、直流変流器を用いたものがあるがゼロ 点のドリフトを考慮すると実際には10 μ A以下の測定は困難であった。ゼロ点の ドリフトを無視できる短時間の測定でも雑音幅は数 μ Aであった。

[0011]

このような状況から、ビームを非破壊で測定することができ、かつ高精度の測定を可能とするビーム電流測定装置および測定方法が求められていた。すなわち、耐雑音性を向上し、測定の連続性が失われることがなく、 10μ A程度以下、望ましくは数 μ A程度以下の雑音幅で微小なビーム電流を安定して測定できる非破壊型の測定方法および測定装置の提供が求められていた。

[0012]

本発明は、前記実情に鑑みてなされたもので、耐雑音特性が良好で、かつ高感度のビーム電流測定装置および測定方法を提供することを目的とする。

また、できるだけ常温近くで使用できるビーム電流測定装置を提供することを 目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明では、外部磁場遮蔽用の磁気遮蔽部と、前記磁気遮蔽部によって生成された遮蔽空間に配された磁場センサとを備え、測定すべきビーム電流が生成する磁場を前記磁場センサで測定するビーム電流測定装置であって、前記磁場センサは、磁束-帰還電流変換係数が8×10-15 Wb/A以上であることを特徴とする。

[0014]

本発明者らは、常伝導体および低温超伝導体と高温超伝導体を用いた種々の実験結果から、センサの感度を従来とは別の領域としたものを用いることにより、耐雑音性が劇的に向上することを発見した。本発明はこの点に着目してなされたものである。

[0015]

本発明によれば、磁束-帰還電流変換係数が8×10-15 Wb/A以上の磁場センサを用いることにより、耐雑音特性が大幅に向上した。

[0016]

かかる構成によれば、耐雑音性が高く、且つ、数十nAから10μA程度相当以下の雑音幅でビーム電流を測定できるビーム電流測定装置を提供できる。

[0017]

また、磁束-帰還電流変換係数が2×10-12 Wb/A以下とすることにより、耐ノイズ特性が良好で、且つ、雑音幅が小さい測定ができる領域となる。

[0018]

また、望ましくは、磁場センサは、磁束-帰還電流変換係数が1×10-12 Wb/A以下である。この理由はより雑音幅が小さい測定ができるからである。

[0019]

また、本発明のビーム電流測定装置は、外部磁場遮蔽用の磁気遮蔽部と、前記磁気遮蔽部によって生成された遮蔽空間に配された磁場センサとを備え、測定すべきビーム電流が生成する磁場を前記磁場センサで測定するものであって、前記磁場センサは、磁束感度が2×10-18 Wb/V以上であることを特徴とする。

[0020]

かかる磁場センサを用いることにより、耐雑音特性が大幅に向上した。 また、望ましくは、前記磁場センサは、磁気感度が 5×10-15 Wb/V以下である ことを特徴とする。

[0021]

また、望ましくは、前記磁場センサは、磁束感度が2×10-15 Wb/V以下であることを特徴とする。

また、望ましくは、前記磁場センサは2個のジョセフソン接合を平行に配置した超伝導リング構造を有することを特徴とする。

この磁場センサはSQUIDと呼ばれている。ここで、SQUIDを貫く磁束量の変化に対する帰還コイルに流れる帰還電流の比を磁束-帰還電流変換係数とする。

[0022]

また、SQUIDを貫く磁束量の変化に対する出力の比を磁束感度とする。

ここで磁東-帰還電流変換係数が 2.95×10^{-13} Wb/A、磁東感度が 5.9×10^{-16} Wb/V程度のSQUIDは高温超伝導体を用いて製造されている。

なお高温超伝導体を用いた方が、液体窒素温度以上で動作できるので望ましい。ここで高温超電導体とは10k以上で超伝導を示す物体をいい、望ましくは30k以上で超伝導を引き起こすものがよい。このような高温超電導体を用いることにより、ランニングコストが安い上遮蔽部が薄くてすうため装置の小型化が可能となる。

[0023]

さらに、SQUIDをイオンビームが流れる空間を含む外部空間から磁気遮蔽する 超伝導体からなる磁気遮蔽部を有する方が、外部磁場を遮蔽して雑音を低減でき るので望ましい。

超伝導体からなる磁気遮蔽部はギャップを有する構造とする方が、外部磁場は 低減して、ビームがつくる磁場だけを選択的に通過させることができるので望ま しい。

[0024]

さらには電場遮蔽部、電磁場遮蔽部を有する方が、パルス状に変動したり高周 波で変動したりする外部電場、電磁場を遮蔽して測定の安定性を向上できるので 望ましい。

また、前記磁気センサは、測定すべきビーム電流が生成する磁場を収集する機構を具備するのが望ましい。

[0025]

また、前記磁場を収集する機構は、軟磁性体コアに超伝導線を巻回したコイル、または表面を高温超伝導体でコーティングし、外周面には一部分だけが高温超 伝導体のブリッジ部分を有する円筒であるのが望ましい。

[0026]

また、電場遮蔽部、電磁場遮蔽部は銅、アルミニウムの群から選ばれる少なく とも1つを含む材質で構成される方が渦電流を発生させ易く電場、電磁場を効率 よくキャンセルできるので望ましい。

例えば数μAから数mA程度のビーム電流を高精度で測定することが求められる イオン注入装置に応用することで、半導体ウェハにイオンビームを照射しながら 、同時に非破壊でビーム電流が測定できる。

[0027]

また本発明のビーム電流測定方法は、上記ビーム電流測定装置を用い、イオン源または電子線源から被処理物表面に照射されるビームライン上に、前記ビーム電流測定装置の磁場センサを配置し、前記磁場センサの出力から、前記ビームラインのビーム電流値を測定するようにしたことを特徴とする。

[0028]

また、本発明のビーム照射方法は、イオン源または電子線源を用いて生成されたビームに対し、上記ビーム電流測定方法を用いてビーム電流を測定する測定工程と、前記測定工程で得られた前記ビーム電流値を、前記イオン源または電子線源の制御パラメータに帰還する制御工程と、前記制御工程で得られた制御パラメータを用いて制御されたビーム電流を被処理物に照射する照射工程とを含むことを特徴とする。

[0029]

さらに上記ビーム電流測定装置を用いたビーム照射装置によれば、高精度にビーム電流を制御しつつビーム照射を行うことが可能となり、高精度の加工が可能となる。

さらに上記ビーム電流測定装置を具備したイオン注入装置、電子ビーム露光装置、加速器を用いて製造あるいは検査した半導体、液晶、バイオチップなどの能動素子および、抵抗、コイル、コンデンサーなどの受動素子も有効である。

[0030]

【発明の実施の形態】

次に本発明の実施の形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。

図1は本発明の実施の形態のビーム電流測定装置を示す説明図である。

このビーム電流測定装置は、図1に示すように、測定すべきビームの経路に配された検知コイル1と、ビーム電流に対応した磁場を検知する磁場センサであるSQUID2と、前記検知コイル1で検知された磁束を測定部に伝達する磁束伝達部としてのワッシャコイル6と、伝達された磁束に感応する超伝導素子と超伝導素子を貫く磁束の変化を打ち消すように帰還電流を流す帰還コイル3とSQUID2カコイル5とSQUID2とを有する測定部とを備え、このSQUID2

の出力をプリアンプ及び積分器を経て出力端子7に導くとともに帰還抵抗4を経て帰還コイル3に帰還させるように構成されている。

[0031]

この装置では、磁場センサ2と、イオンビームが流れる空間とを含む空間から 磁気遮蔽する超伝導体からなるギャップを有する磁気遮蔽部によってその主要部 が構成されている。検知コイル1は、軟磁性体のコアに超伝導線を巻回したコイ ルであって、ビーム電流によって発生した磁場を軟磁性体コアで収集してコイル に超伝導電流を誘起する。このコイルに誘起された超伝導電流は、SQUID2に隣 接して配置したコイルまで伝達される。ビーム電流の変化に対応して、このコイ ルに流れる超伝導電流が変化することでSQUIDを貫く磁束量が変化しようとする 。しかし、SQUIDを貫く磁束量が変化しないように、変化を打ち消すように帰還 コイルに帰還電流を流す仕組みとしている。この帰還電流がビーム電流値の変化 に比例しており、帰還電流を測定することでビーム電流値の変化量を決定できる

[0032]

8は磁気遮蔽部、9はギャップである。このギャップの存在により、所望の方向に磁場センサを出力することができる。そして、帰還電流が帰還抵抗4の両端に発生させる電圧を出力7としてオシロスコープでモニターする。磁気遮蔽部は鉛で作成したギャップのある超伝導磁気遮蔽部を用いる。ギャップは入れ子形状に7段で構成されている。そして検知コイル1とSQUID2を磁気遮蔽部の中に入れた。測定すべきビーム電流のつくる磁場はギャップを通じて検知コイル1に到達する。なお、望ましくは、磁気遮蔽部8に加えて電気遮蔽機能も備えた遮蔽体を用いるようにする。

[0033]

この装置では、検知コイル1を構成する円筒の中央を貫いたビーム電流は円筒の表面に表面遮蔽電流を誘起する。そして、ブリッジ部分には表面遮蔽電流が集中する。このようにして、集中させた表面遮蔽電流がつくる磁束をSQUIDで測定する。

[0034]

この方法において使用されているSQUIDは高温超伝導体を用いたものであり、 液体窒素温度以上で動作させることができるものである。ここでは、イオンビー ムの替わりに巻いた1ターンコイルに模擬電流を流して実験を行った。

[0035]

この装置では、磁東-帰還電流変換係数は2.95×10-13 Wb/A、磁東感度が5.9 ×10-16 Wb/Vの高温SQUIDを磁場センサ2として使用し、駆動回路を用いたビーム電流測定装置とする。つまり磁東-帰還電流変換係数および磁東感度が従来用いられていた非特許文献2に記載の高温超電導体を用いたもの(比較例1として後述する)よりも2桁高く、高温超伝導体を用いて本発明者らが作成した低温超伝導体を用いたもの(比較例2として後述する)よりは2桁低いものを用いる。その他は従来用いられていたもの(比較例1)と同じ条件とする。

[0036]

ここで、SQUID 2 の超伝導閉回路が満足する磁束の保存則はMis・Ip +Mfs・If = 0である。ただし、MisはSQUID入力コイル 5 とSQUID 2 の相互インダクタンス、Ipは検知コイル 1 とワッシャーコイル 6 とSQUID入力コイル 5 がつくる超伝導閉回路を流れる超伝導電流、Mfsは帰還コイル 3 とSQUID 2 の相互インダクタンス、Ifは帰還コイル 3 を流れる帰還電流である。帰還抵抗 4 の大きさをRfとする。第1項がSQUID 2 に入力される磁束であり、If・Rfが出力 7 の電圧である。よって磁束感度はMis・Ip/If・Rfで求まる。また磁束ー帰還電流変換係数はMis・Ip/Ifで求まる。

[0037]

このときのビーム電流―電圧変換係数は、磁束感度から1.5×10-4 A/Vと見積 もることができる。つまり、模擬電流に対する出力は0.67 mV/100 nA程度と見積 もることができる。雑音幅は、比較例1から2 mV程度まで低減できると考えられ る。これは300 nA程度の模擬電流に相当する。

[0038]

以上のように本発明実施例によれば300 nA程度の雑音幅でビーム電流を測定することができる。

[0039]

次に、比較例について説明する。

(比較例1)

高温超伝導体のSQUID (B) と駆動回路を用いて実験を行った。検知部は表面を高温超伝導体でコーティングした円筒を用いた。そして、従来の技術で説明したように円筒の外周面に一部分だけが高温超伝導体のブリッジ部分を設けて、ブリッジ部分に集中した表面遮蔽電流がつくる磁束をSQUIDと駆動回路で測定した。比較例1で用いた高温SQUID (B) と駆動回路の磁束ー帰還電流変換係数は1.15×10-11 Wb/A、磁束感度は3.84×10-14 Wb/Vである。

[0040]

ここでも、イオンビームの替わりに巻いた1ターンコイルに模擬電流を流して実験を行った。模擬電流はビーム電流測定装置ビーム通過孔の軸上付近を通過するように巻いた1ターンコイルに電流を流して作成した。このとき、1 mAの模擬電流に対して出力は40 mVであった。

つまり、ビーム電流—電圧変換係数は 2.5×10^{-2} A/Vである。雑音幅は2 mV程度であった。これは 50μ A程度に相当する。

[0041]

以上のように数 μ A相当以下の雑音幅でビーム電流を測定することはできない。一方、雑音によりSQUIDのロックが外れることはなく、安定した測定が可能であった。

[0042]

(比較例 2)

低温超伝導体のSQUIDと駆動回路を用いて実験を行った。装置としては図1に示した本発明の実施例と同様の構成をもつおのであり、磁場センサのみがことなるもので、比較例 2 では、磁束感度は 1.8×10^{-18} Wb/Vであり、実施例よりも感度が 2 桁高いものを用いた。磁束-帰還電流変換係数は 8.46×10^{-15} Wb/Aであり、実施例よりも感度が 2 桁高いものを用いた。このとき、10 nAの模擬電流に対して出力 7 は40 mVであった。

[0043]

また、検知部と測定部の間の磁束伝達率を最大化するようにトランスを設けた

実験では、10 nAの模擬電流に対して出力 7 ta70 mVであった。つまり、ビーム電流一電圧変換係数は $1.4 \sim 2.5 \times 10^{-7} \text{ A/V}$ である。雑音幅は両方の場合でほぼ同じであり、10 mV程度であった。雑音幅は $1.4 \sim 2.5 \text{ nA}$ 程度に相当し、数nA程度相当の雑音幅でビーム電流を測定できる。一方、雑音には敏感であり、SQUID2 のロックが外れることがある。この例でも磁気遮蔽に加えて、外部電場と機械的振動の遮断を行うことでロックが外れる頻度は低減するが、一般的な製造工程の環境で使用するためには測定の安定性が課題であった。

[0044]

ところで、比較例2におけるSQUIDのロックが外れる原因となるような外部からの雑音は単位時間あたりの磁束変動が大きいパルス状の雑音である。単位時間あたりの磁束変動が駆動回路の追随性の限界を超えるとロックが外れてしまう。

そこで、実施例では比較例2より磁束感度が2桁低いSQUIDと駆動回路を用いている。これにより単位時間あたりの磁束変動が2桁大きい外部雑音が発生した場合にのみロックが外れることになる。ところで単位時間あたりの磁束変動が2桁大きい外部雑音が発生する頻度は極端に少なく、2桁以上発生する頻度が低下すると考えられる。

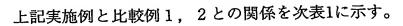
[0045]

さらには、単位時間あたりの磁束変動が2桁以上も大きいような外部の雑音は、その雑音源を特定することが比較的簡単である。よって雑音源からの雑音電磁場の発生自体を低減したり、特定の雑音源を取り除いたりという対策がとりやすい。これにより上記のような単位時間あたりの磁束変動が大きい雑音の発生頻度はほとんど零にすることが可能であると考えられる。

[0046]

ここで、ロックが外れない程度に単位時間あたりの磁束変動が小さいパルス状の外部雑音は、適当な遮断周波数のロー・パスフィルターを用いて出力信号から除外することができるので、余り問題にはならない。以上のことから、雑音によってSQUIDのロックが外れることがなく、安定した測定が可能になると考えられる。

[0047]



【表1】

	(比較例1) 高温超伝導SQUID (B)	(発明例) 高温超伝導SQUID (A)	(比較例2) 低温超伝導SQUID (C)
磁場分解能	1 pT/√Hz	34 fT/√Hz	10 fT/√Hz
磁束感度	$3.84 \times 10^{-14} \text{ Wb/V}$	$5.9 \times 10^{-16} \text{ Wb/V}$	$1.8 \times 10^{-18} \text{ Wb/V}$
磁束一帰還電流 変換係数	1.15×10 ⁻¹¹ Wb/A	$2.95 \times 10^{-13} \text{ Wb/A}$	8.46 × 10 ⁻¹⁵ Wb/A
ビーム電流一電圧 変換係数	2.5 × 10 ⁻² A/V	1.5 × 10 ⁻⁴ A/V	1.4~2.5×10 ⁻⁷ A/V
測定の連続性 が失われた頻度	数回/時間	記組/回口み	ゼロ回/時間

[0048]

また、図2に磁束感度とビーム電流一電圧変換係数の関係曲線を示す。この結

果から、磁束感度とビーム電流—電圧変換係数は比例関係にあると考えられる。 雑音幅は電子機器の一般的な雑音幅と比較例 1 から2 mV程度まで低減させることができると考えられる。2 mVの雑音幅が 10μ Aに相当するには 5×10^{-3} A/Vのビーム電流—電圧変換係数が必要であることがわかる。

[0049]

このことと上記の比例関係から 10μ A相当の雑音幅でビーム電流を非破壊型で測定できる条件は、磁束感度が 5×10^{-15} Wb/V以下のときと推定できる。この条件が課題を解決するために必要である。磁束感度は高い方が見かけ上の雑音幅が小さくなる。

[0050]

しかし、感度が高いと耐雑音性が低下し、特にパルス状の外部雑音によってSQ UIDのロックが外れやすくなるという課題が発生する。そこで、磁束感度は2×10 -18 Wb/V以上の方が安定した測定が可能になるので望ましい。

[0051]

以上のように測定の安定性を保って、且つ、雑音幅を数 μ A相当以下にするためには、磁束感度が 2×10^{-18} Wb/V以上、且つ、 5×10^{-15} Wb/V以下であることが望ましい。

[0052]

図3は磁東-帰還電流変換係数とビーム電流—電圧変換係数の関係を示す図である。磁東-帰還電流変換係数とビーム電流—電圧変換係数は比例関係にあると考えられる。

[0053]

上記磁束感度に関する記述と同様に、測定の安定性を保って、且つ、雑音幅を 10μ A相当以下にするためには、磁束-帰還電流変換係数が 8×10^{-15} Wb/A以上、且つ、 2×10^{-12} Wb/A以下であることが望ましい。

[0054]

より望ましくは、数 μ A相当の雑音幅でビーム電流を非破壊型で測定できるためには、磁束ー帰還電流変換係数が 1×10^{-12} Wb/A以下、磁束感度が 2×10^{-15} Wb/V以下のときと推定できる。

[0055]

【発明の効果】

以上説明してきたように、本発明によれば耐雑音性能が高く、高感度で取り扱い作業性の良好なビーム電流測定装置を提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明実施例のビーム電流測定装置を示す図である。
- 【図2】磁束感度とビーム電流―電圧変換係数の関係を示す図である。
- 【図3】磁束-帰還電流変換係数とビーム電流-電圧変換係数の関係を示す図である。

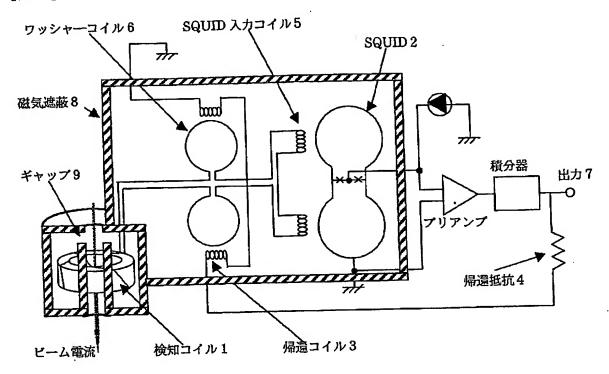
【符号の説明】

- 1 検知コイル
- 2 SQUID
- 3 帰還コイル
- 4 帰還抵抗
- 5 SQUID入力コイル
- 6 ワッシャーコイル
- 7 出力

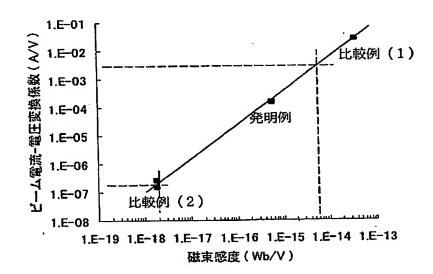


図面

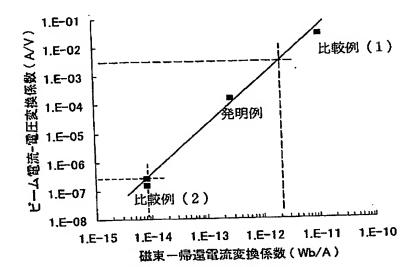
【図1】



【図2】



【図3】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】耐雑音性が高く、高感度のビーム電流測定を実現することのできる非破 壊型の測定方法および測定装置を提供する。

【構成】外部磁場遮蔽用の磁気遮蔽部と、前記磁気遮蔽部によって生成された遮蔽空間に配された磁場センサとを備え、測定すべきビーム電流が生成する磁場を前記磁場センサで測定するビーム電流測定装置であって、前記磁場センサの磁束 - 帰還電流変換係数を8×10-15 Wb/A以上とする。

【選択図】図1

1

【書類名】

出願人名義変更届 (一般承継)

【提出日】 【あて先】 平成15年12月 1日 特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】

特願2003-71028

【承継人】

【識別番号】

503359821

【住所又は居所】 【氏名又は名称】 埼玉県和光市広沢2番1号 独立行政法人理化学研究所

【承継人代理人】

【識別番号】

100075812

【弁理士】

【氏名又は名称】

吉武 賢次

【提出物件の目録】

【物件名】

権利の承継を証明する書面 1

【援用の表示】

平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】

がける』 【援用の表示】 平

登記簿謄本 1 平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】

委任状 1

ţ

【物件名】

委任状

【添付書類】""。 (/ IIIIIIII 735





私は、

識別番号 100075812 弁理士 吉 氏 を代理人と定めて下記事項を委任する。

任

以上

平成 / 5年 // 月 / 9日

住所又は居所

埼玉県和光市広沢2番1

氏名又は名称

独立行政法人 理化学研

代 表 者

理事長.野 依 良

目録(1)

1.	特顧昭63-235737	51.	特願平07-327372
2.	特顯平05-044143	52.	特願平08-000652
3.	特願平05-127257	53.	特願平08-026368
4.	特願平05-127258	54.	特願平08-030850
5.	特願平05-213675	55.	特顧平08-041279
6.	特願平05-306164	56.	特願平08-045903
7.	特願平05-328611	57.	特願平08-051604
8.	特顯平05-336746	58.	特願平08-065715
9.	特願平06-035100	59.	特顯平08-070071
10.	特願平06-061792	60.	特願平08-105667
11.	特願平06-061793	61.	特願平08-107784
12.	特願平06-069150	62.	特願平08-116473
13.	特願平06-097098	63.	特願平08-123475
14.	特顧平06-111624	64.	特顧平08-127005
15.	特額平06-121100	65.	特願平08-131746
16.	特願平06-145908	66.	特願平08-132846
17.	特願平06-158670	67.	特願平08-132854
18.	特願平06-158671	68.	特願平08-142676
19.	特願平06-165751	69.	特願平08-158078
20.	特願平06-165752	70.	特願平08-167401
21.	特願平06-181857	71.	特願平08-196331
22.	特願平06-235742	72.	特願平08-197050
23.	特願平06-238603	73.	特願平08-197051
24.	特願平06-244764	74.	特願平08-211946
25.	特願平06-248486	75.	特願平08-216506
26.	特願平06-252942	76.	特願平08-216508
27.	特願平06-268723	77.	特顯平08-222352
28.	特願平06-293933	78.	特願平08-231066
29.	特願平06-301372	79.	特願平08-233442
30.	特願平06-323795	80.	特願平08-236685
31.	特願平06-324490	81.	特願平08-251410
32.	特願平06-507966(科	R2002-12420) 82.	特顧平08-262051
33.	特願平07-007185	83.	特願平08-302896
34.	特願平07-069255	84.	特願平08-308335
35.	特願平07-082880	85.	特願平08-308336
36.	特願平07-083142	86.	特願平08-311467
37.	特願平07-117933	87.	、特願平08-315093
38.	特願平07-133487	88.	特願平08-317622
39.	特願平07-205141	89.	特願平08-320241
40.	特願平07-214659	90.	特願平08-506395
41.	特願平07-217276	91.	特願平09-002295
42.	特願平07-236185	92.	特願平09-010602
43.	特願平07-240684	93.	特願平09-019968
44.	特願平07-249244	94.	特願平0:9-019969
45.	特願平07-259922	95.	特願平09-019971
46.	特願平07-282716	96.	特願平09-024890
47.	特願平0.7-302793	97.	特願平09-028982
48.	特願平07-306004	98.	特願平09-046824
49.	特願平07-300004	99.	特願平09-049254
50.	特願平07-311711	100.	特願平09-053478
	1940(10)		

目録(2)

101.	特顯平09-054595	151. 特願平10-045434
102.	特願平09-056654	152. 特願平10-049499
103.	特願平09-057342	153、 特願平10-049867
104.	特願平09-058774	154. 特願平10-051489
105.	特顯平09-067611	155. 特顧平10-051490
106.	特顧平09-074394	156. 特願平10-051491
107.	特願平09-080480	157. 特願平10-051492
108.	特顯平09-082965	158. 特願平10-051493
109.	特願平09-091523	159. 特願平10-060740
110.	特願平09-091591	160. 特願平10-060741
111.	特願平09-091694	161. 特願平10-061895
112.	特願平09-096968	162. 特願平10-076139
113.	特願平09-099061	163. 特願平10-085207
114.	特願平09-099109	164. 特願平10-085208
115.	特顯平09-104093	165. 特顯平10-103083
116.	特願平09-119730	166. 特願平10-103115
117.	特願平09-129068	167. 特願平10-103671
118.	特願平09-134525	168. 特願平10-104093
119.	特願平09-147964	169. 特願平10-113493
120.	特願平09-155364	170. 特願平10-116378
121.	特願平09-159963	171. 特願平10-121456
122.	特願平09-163630	172. 特願平10-127520
123.	特願平09-163631	173. 特願平10-136198
124.	特願平09-171924	174. 特顯平10-149603
125.	特願平09-175896	175. 特願平10-150494
126.	特願平09-180423	176、特願平10-151245
127.		177. 特願平10-155838
128.	特願平09-198201	178. 特顯平10-155841
129.		179. 特願平10-156104
130.		180. 特願平10-156108 181. 特願平10-198313
131.		
132.	特願平09-230870	182. 特願平10-200280 183. 特願平10-217132
133.	特願平09-253740	184. 特顏平10-217180
134.		185. 特願平10-222837
135.		186. 特願平10-227939
136.		187. 特願平10-229591
137.		188. 特顯平10-232520
138. 139.		189. 特願平10-232590
140		190. 特顯平10-236009
141	. 特顧平09-327140	191. 特顯平10-237485
142		192. 特願平10-238144
143		193. 特願平10-245293
144		194. 特顯平10-250598
145		195. 特顯平10-250611
146		196. 特願平10-252128
147		197. 特願平10-260347
148		198. 特願平10-260416
149	• • • • •	199. 特願平10-268791
150		200. 特願平10-269859
100	OCCUPE OF PARTE "	

目録(3)

201. 特願平10-272529	251. 特願平11-135137
202. 特願平10-280351	252. 特願平11-135482
203. 特願平10-308533	253. 特願平11-143429
204. 特願平10-309765	254. 特願平11-144005
205. 特願平10-311673	255. 特願平11-147097
206. 特願平10-311674	256. 特願平11-151099
207. 特願平10-311675	257. 特願平11-166247
208. 特願平10-314856	258. 特願平11-173839
209. 特願平10-315751	259. 特願平11-179278
210. 特願平10-338896	260. 特願平11-186052
211. 特願平10-338897	261. 特顯平11-193235
212. 特願平10-338898	262. 特願平11-224269
213. 特願平10-338899	263. 特願平11-225060
214. 特願平10-352428	264. 特願平11-225832
215. 特願平10-354665	265. 特願平11-225839
216. 特願平10-363297	266. 特願平11-226176
217. 特顧平10-363329	267. 特願平11-234800
218. 特願平10-506788	268. 特顯平11-240325
219. 特願平10-532832	269. 特願平11-240910
220. 特顯平10-535583	270. 特願平11-241737
221. 特願平11-008183	271. 特願平11-242438
222. 特願平11-013380	272. 特願平11-242490
223. 特願平11-015176	273. 特願平11-253851
224. 特願平11-031724	274. 特顧平11-260947
225. 特願平11-035776	275. 特願平11-277759
226. 特顯平11-046372	276. 特願平11-278976
227. 特願平11-055835	277. 特願平11-279324
228. 特願平11-055867	278. 特願平11-281632
	. 279. 特願平11-303976
230. 特顯平11-056957	280. 特願平11-309616
231. 特願平11-057381	281. 特願平11-315036
232. 特顯平11-057749	282. 特願平11-321282
233. 特顯平11-058103	283. 特顯平11-336079
234. 特願平11-061079	284. 特願平11-346467
235. 特願平11-061080	285. 特願平11-354563
236. 特願平11-064193	286. 特願平11-360274
237. 特願平11-064372	287. 特顧平11-365899
238. 特願平11-064506	288. 特願平11-373483
239. 特願平11-065136	289. 特願平11-510791
240. 特願平11-074385	290. 特願平11-515324
241. 特願平11-081225	291. 特願2000-001783
242. 特願平11-090383	292. 特顧2000-005221
243. 特願平11-091875	293. 特願2000-009363
244. 特顯平11-103231	294. 特願2000-010516
244. 特願平11-103231 245. 特願平11-104509	295. 特顯2000-011147
246. 特顯平11-106920	296. 特顯2000-011623
247. 特願平 1 1 - 1 2 4 1 8 7	297. 特顧2000-016518
248. 特願平11-130771	298. 特顧2000-016622
249. 特願平11-130814	299. 特願2000-017-112
250. 特願平11-130815	300. 特顧2000-018612
700. 14 M/L L I L C C I C	

目錄(4)

301.	特顧2000-019195	351.	特願2000-141763
302.	特願2000-019528	352.	特願2000-148843
303.	特願2000-020067	353.	特願2000-152455
304.	特願2000-030321	354.	特願2000-152469
305.	特顧2000-034109	355.	特願2000-154484
306.	特願2000-039082	356.	特願2000-161895
307.	特願2000-040355	357.	特顧2000-163122
308.	特願2000-041927	358.	特願2000-164584
309.	特願2000-041929	359.	特願2000-179723
310.	特願2000-045318	360.	特願2000-181281
311.	特顧2000-045855	361.	特願2000-184259
312.	特顧2000-051488	362.	特顯2000-184295
313.	特願2000-051650	363.	特願2000-191007
314.	特願2000-052040	364.	特顧2000-191265
315.	特願2000-053707	365.	特願2000-192332
316.	特願2000-054949	366.	特顧2000-193817
317.	特顧2000-056093	367.	特顯2000-195384
318.	特顧2000-056879	368.	特願2000-196991
319.	特願2000-057564	369.	特願2000-197022
320.	特願2000-057565	370.	特願2000-202801
321.	特願2000-057566	371.	特願2000-216457
322.	特顧2000-058133	372.	特願2000-223714
323.	特願2000-058282	373.	特願2000-224970
324.	特願2000-062316	374.	特願2000-225486
325.	特願2000-064142	375.	特顧2000-225864
326.	特願2000-064209	376.	特願2000-225978
327.	特願2000-071119	377.	特願2000-226361
328.	特願2000-076122	378.	特願2000-229191
329.	特願2000-085874	379.	特願2000-230551
330.	特願2000-089078	380.	特顧2000-237165
331.	特願2000-092693	381.	特願2000-237166
332.	特願2000-100395	382.	特願2000-237533
333.	特顧2000-105139	383.	特願2000-246309
334.	特願2000-105917	384.	特願2000-248331
335.	特顧2000-107160	385.	特願2000-249232
336.		386.	・特顧2000-256149
337.		387.	特顧2000-257080
338.		388.	特顧2000-257083
339.		389.	特顯2000-260030
340.		390.	特顯2000-261233
341.		391.	特願2000-264743
342.		392.	特顯2000-265344
343.		393.	特顧20.0.0-278502
344.		394.	特願2000-279557
345.		395.	
346.		396.	
347.		397.	
348.		398.	
349.		399.	
350.		400.	
500	19494 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2301	

目録(5)

401.	特願2000-319775	451. 特願2001-071435
402.	特願2000-322056	452. 特願2001-072650
403.	特願2000-333311	453、特願2001-072668
404.	特顯2000-334686	454. 特願2001-072963
405.	特願2000-334969	455. 特顧2001-073028
406.	特願2000-343912	456. 特願2001-074964
407.	特願2000-347398	457. 特顧2001-074965
408.	特願2000-347865	458. 特顧2001-077257
409.	特願2000-358121	459. 特額2001-078671
410.	特顯2000-368566	460. 特額2001-084173
411.	特顧2000-374626	461. 特願2001-089541
412.	特願2000-375090	462. 特願2001-091911
413.	特願2000-378421	463. 特願2001-092337
414.	特願2000-378942	464. 特顧2001-116171
415.	特顧2000-378950	465. 特願2001-124294
416.	特顯2000-384771	466. 特願2001-124452
417.	特願2000-387016	467. 特顧2001-127575
418.	特願2000-394815	468. 特願2001-127576
419.	特顧2000-396445	469. 特願2001-135357
420.	特顧2000-399940	470. 特願2001-137087
421.	特願2000-400336	471. 特願2001-138103
422.	特願2000-401110	472. 特願2001-142583
423.	特顧2000-401245	473. 特願2001-147081
424.		474. 特願2001-152364
425.	特願2000-503838	475. 特願2001-152379
426.		476. 特願2001-153447
427.		477. 特顧2001-155572
428.		478. 特願2001-163740
429.		479. 特顧2001-164819
430.	特願2000-618709	480. 特顧2001-164997
431.		481、特願2001-165133
432.	特顧2001-005615	482. 特願2001-167910
433.		483. 特願2001-168784 484. 特願2001-171705
434.	特顧2001-016626	484. 特顧 2001-171705 485. 特顧 2001-173331
435.		486. 特顧2001-174421
436.	特顧2001-037141	487. 特願2001-174553
437.		488. 特顧2001-175898
438.		489. 特顧2001-178169
439.		490. 特顯2001-179858
440.		491. 特顧2001-180552
441.		492. 特願2001-180554
442		493. 特願2001-187735
443 444		494. 特願2001-197185
444		495. 特顧2001-197897
445 446		496. 特願2001-200854
440 447		497. 特願2001-201356
44 7 448		498. 特願2001-202971
440 449		499. 特願2001-203089
450		500. 特願2001-206505
400	TURNETO TO OUT OUT	000. 10mm = 0 = = 0 0 0 0

目録(6)

501. 特願2001-206522	551. 特願2001-325367
	552. 特願2001-326872
502. 特願 2 0 0 1 - 2 0 6 5 2 3	553. 特顯2001-327853
503. 特願2001-209305	554. 特願2001-329023
504. 特願 2 0 0 1 - 2 1 2 9 4 7	555. 特願2001-332168
505. 特願2001-216505	
506. 特願2001-220219	
507. 特顯2001-226176	
508. 特願2001-228287	
509. 特願2001-228374	
510. 特願2001-235412	
511. 特願2001-235747	
512. 特願2001-238951	562. 特顧2001-349614
513. 特願2001-241023	563. 特願2001-351730
514. 特願2001-243930	564. 特顧2001-352189
515. 特願2001-246642	565. 特願2001-353038
516. 特願2001-249976	566. 特願2001-358446
517. 特願2001-254377	567. 特顧2001-358581
518. 特願2001-254378	568. 特顯2001-359710
519. 特顯2001-255589	569. 特願2001-374928
520. 特願2001-256576	570. 特願2001-376591
521. 特願2001-257188	571. 特願2001-378757
522. 特願2001-261158	572. 特願2001-380473
523. 特願2001-266004	573. 特願2001-382537
524. 特願2001-266069	574. 特願2001-382539
525. 特願2001-266454	575. 特願2001-382599
526. 特願2001-267194	576. 特顧2001-385258
527. 特願2001-267379	577. 特願2001-385512 578. 特顧2001-385513
528. 特願2001-267863	
529. 特願2001-272977	
530. 特願2001-273964	
531. 特願2001-276053	581. 特願2001-390122 582. 特願2001-392087
532. 特願2001-279406	583. 特願2001-392088
533. 特願2001-280319	584. 特顧2001-395196
534. 特願2001-285145	585. 特願2001-396120
535. 特願2001-291059 536. 特願2001-292223	586. 特願2001-397762
	587. 特願2001-397998
	588. 特願2001-401139
	589. 特顧2001-515803
	590. 特願2.001-523852
	591. 特顯2001-557672
	592. 特願2002-000993
	593. 特願2002-005746
	594. 特願2002-010344
	595. 特願2002-011558
	596. 特顧2002-019752
	597. 特顧2002-020329
	598. 特願2002-022499
	599. 特願 2 0 0 2 - 0 2 8 0 4 6
	600. 特願2002-028109
550. 特願2001-319360	DUD. TURKEDOE OF TOTAL

目 録(7)

601.	特願2002-040151	651. 4	時顧2002-162157
602.	特願2002-042829		時願2002-162211
603.	特願2002-044340		時顧2002-162365
604.	特願2002-044640		特願2002-167759
605.	特願2002-046188		持願2002-170068
606.	特願2002-047799		特願2002-170902
607.	特顧2002-053190		特願2002-176435
608.	特願2002-053575		特願2002-176583
609.	特願2002-055272		特願2002-183722
610.	特願2002-057253		特願2002-185966
611.	特願2002-057565		特願2002-187362
612.	特願2002-057935		特願2002-187957
613.	特願2002-057963		特顧2002-188281
614.	特願2002-066249		特願2002-189265
615.	特顧2002-070624		特顧2002-194627
616.	特顧2002-070987		特願2002-197812
617.	特願2002-071924		特願2002-201443
618.	特顧2002-074902		特顧2002-201575
	特顧2002-078184		特願2002-202118
619. 620.	特願2002-081467	670.	特願2002-205814
621.	特願2002-081502	671.	特願2002-205825
622.	特願2002-083081	672.	特顧2002-217714
623.	特願2002-084139	673.	特願2002-221188
624.	特願2002-085017	674.	特願2002-225469
625.	特願2002-087342	675.	特願2002-225724
626.	特願2002-094681	676.	特願2002-226859
627.	特願2002-095132	677.	特額2002-227286
628.	特願2002-095389	678.	特願2002-229686
629.		679.	特顧2002-230562
630.		680.	特願2002-235294
631.		681.	特願2002-235737
632.		682.	特顧2002-236838
633.	· ·	683.	特願2002-237058
634.		684.	特願2002-237092
635.		685.	特願2002-248946
636.		686.	特願2002-253322
637.		687.	物頭2002-253689
638.		688.	特願2002-253697
639		689.	特願2002-254096
640		690.	特願2002-257924
641	41	691.	特願2002-260788
642		692.	特顧2002-261499
643		693.	特顧2002-264969
644		694.	特願2002-267114
645		695.	特願2002-268987
646		696.	特願2002-270917
647		697.	特願2002-271375
		698.	特願2002-271473
648		699.	特願2002-273996
649		700.	特願2002-274469
650	・ 村朝でのででしてまる	100.	TURNET C C C TRADE

目録(8)

```
特願2002-276051
                          751.
                              特願2003-012738
701.
702.
   特願2002-282746
                          752.
                              特願2003-012774
703.
   特額2002-286487
                          753.
                              特願2003-015968
704.
   特願2002-289209
                          754.
                              特願2003-016044
                              特願2003-016940
705.
   特願2002-295332
                          755.
   特願2002-296911
                          756.
                              特願2003-017397
706.
   特願2002-299429
                          757.
                              特願2003-021499
707.
708.
   特願2002-301875
                          758.
                              特願2003-024347
709.
   特願2002-303838
                          759.
                              特顯2003-024620
710.
   特願2002-312131
                          760.
                              特願2003-025277
   特願2002-320102
                              特願2003-027647
711.
                          761.
712.
   特顧2002-320704
                          762.
                              特願2003-027648
713.
   特願2002-325909
                          763.
                              特願2003-031882
714.
   特顧2002-325920
                          764.
                              特額2003-032932
                              特顧2003-038206
715.
   特願2002-332232
                          765.
716.
   特願2002-339344
                          766.
                              特願2003-040642
717.
   特願2002-339392
                          767.
                              特願2003-043961
718.
   特願2002-339541
                          768.
                              特願2003-050153
                              特願2003-050446
719.
   特願2002-339551
                          769.
720.
   特願2002-341195
                          770.
                              特顯2003-052520
721.
   特願2002-343807
                          771.
                              特顧2003-052602
   特願2002-344279
                          772.
722.
                              特願2003-052613
723.
   特願2002-345597
                          773.
                              特願2003-052877
724.
   特願2002-347401
                          774.
                              特願2003-053023
725.
   特願2002-348760
                          775.
                              特願2003-054182
726.
   特願2002-349042
                          776.
                              特願2003-054798
727.
   特願2002-354594
                          777.
                              特願2003-054799
728.
   特額2002-357768
                          778.
                              特願2003-054846
    特願2002-357900
                              特願2003-054847
729.
                          779.
   特願2002-358019
                          780.
                              特願2003-054848
730.
    特願2002-358967
                          781.
                              特願2003-054849
731.
732.
    特顧2002-360972
                          782.
                              特顧2003-055452
733.
    特願2002-360975
                          783.
                              特願2003-056628
734.
    特願2002-368112
                          784.
                              特願2003-061426
735.
    特願2002-37655
                          785.
                              特願2003-063532
    特願2002-376774
                              特顧2003-065013
736.
                          786.
    特顧2002-376831
                              特願2003-071028
737.
                          787.
    特顧2002-379214
                              特顧2003-072979
738.
                          788.
739.
    特願2002-380624
                           789.
                              特顧2003-074168
740.
    特願2002-381888
                           790.
                              特願2003-076107
741.
    特願2002-382170
                          791.
                              特願2003-078999
    特顧2002-383870
                          792.
                              特願2003-079598
742.
    特顧2002-521644
                           793.
                              特願2003-079613
743.
744.
    特願2002-532458
                           794.
                              特願2003-082466
    特願2002-546564
                           795.
                              特願20:03-083318
745.
    特願2002-548185
                           796.
                              特願2003-083433
746.
747.
    特願2002-570743
                           797.
                              特顧2003-083480
                              特願2003-085193
748.
    特願2003-003450
                           798.
749.
    特願2003-012550
                           799.
                              特願2003-089026
750.
    特願2003-012694
                           800.
                              特願2003-090331
```

目録(9)

		·
801.	特顧2003-091446	851. 特顧2003-127135
802.	特願2003-092654	852. 特顧2003-127150
803.	特願2003-093642	853. 特願2003-128818
804.	特願2003-094272	854. 特願2003-128897
805.	特願2003-094719	855. 特願2003-129347
806.	特願2003-095770	856. 特願2003-131313
807.	特顧2003-095884	857. 特顧2003-132280
808.	特願2003-095885	858. 特願2003-132605
809.	特願2003-095886	859. 特願2003-132606
810.	特願2003-095904	860. 特願2003-135591
811.	特願2003-097283	861. 特願2003-136445
812.	特顧2003-097327	
813.	特願2003-091327	
	特願2003-101917 特願2003-104928	
814.		864、特願2003-142303
815.	特願2003-105362	865. 特願2003-143932
816.	特願2003-107267	866、特願2003-145221
817.	特願2003-107268	867. 特願2003-145390
818.	特願2003-107647	868. 特願2003-147820
819.	特願2003-107885	869. 特願2003-150690
820.	特願2003-109575	870. 特願2003-153014
821.	特願2003-115750	871. 特願2003-153015
822.	特願2003-115793	872. 特願2003-153016
823.	特願2003-115847	873. 特顧2003-153985
824.	特顧2003-115888	874. 特顧2003-154009
825.	特願2003-116232	875. 特願2003-154841
826.	特願2003-116895	876. 特願2003-155397
827.	特願2003-118161	877. 特顧2003-155407
828.	特顧2003-118186	878. 特顧2003-158017
829.	特顧2003-119749	879. 特顧2003-161005
830.	特願2003-119930	880. 特願2003-164126
831.	特願2003-120934	881. 特願2003-170051
832.	特願2003-121233	882. 特顧2003-170324
833.	特願2003-121261	883. 特願2003-170325
834.	特願2003-121273	884. 特願2003-170326
835.	特願2003-121780	885. 特顧2003-170327
836.	特顧2003-122245	886. 特顧2003-170328
837.	特願2003-123984	887. 特顧2003-170329
838.	特願2003-124654	888. 特顧2003-170330
839.	特願2003-124655	889. 特願2003-170573
840.	特願2003-124826	890. 特願2003-171576
841.	特願2003-124829	891. 特願2003-171619
842.	特願2003-124833	892. 特顧2003-172898
843.	特願2003-124835	893. 特顧2003-175819
844.	特願2003-125388	894. 特顧2003-177298
845.	特願2003-125403	895. 特願2003-180198
846.	特願2003-125405	896. 特顧2003-182958
847.	特願2003-127090	897. 特願2003-192763
848.	特願2003-127093	898. 特願2003-192775
849.	特願2003-127109	899. 特願2003-194837
850.	特願2003-127130	900. 特願2003-194637
ouv.	TO DE LA LA COU O ROUT	JUU. 大の版人といい3-187228

目錄(10)

901.	特願2003-198340
902.	特願2003-204075
903.	特願2003-205349
904.	特願2003-205710
905.	特願2003-206546
906.	特願2003-207698
907.	特顧2003-207771
908.	特願2003-207772
909.	特願2003-207850
910.	特願2003-270049
911.	特願2003-271473
912.	特願2003-272421
913.	特願2003-275055
914.	特願2003-277958
915.	特顯2003-279130
916.	特顧2003-273130
917.	
918.	特願2003-284055 特願2003-286640
919.	特願2003-289138
920.	特顯2003-293912
921.	特願2003-293912 特願2003-296474
922.	特願2003-296474
923.	特願2003-298424
924.	特顧2003-299424
924. 925.	
925. 926.	特願2003-304452 特願2003-304453
927.	
	特願2003-305689
928. 929.	特願2003-305844 特願2003-306137
929. 930.	
930. 931.	
	特願2003-313014
932. 933.	特願2003-315355 特願2003-318801
934.	
935.	特願2003-321497 特願2003-322948
936.	
937.	
938.	
939.	特願2003-327907 特願2003-328600
940.	
941.	特願2003-328840
942.	特願2003-330418
943.	特願2003-330569
944.	特願2003-331848
945.	特顯2003-332756
946.	特願2003-333798
947.	特顧2003-333932
948.	特願2003-334036
949.	特顯2003-334083
950.	特顯2003-336365

951. 特願2003-338191 952. 特願2003-339542 953. 特願2003-340181 954. 特顯2003-342519

ページ: 1/E

認定 · 付加情報

特許出願の番号 特願2003-071028

受付番号 20308550780

書類名 出願人名義変更届 (一般承継)

作成日 平成16年 3月24日

<認定情報・付加情報>

【提出された物件の記事】

【提出物件名】 委任状(代理権を証明する書面) 1

【書類名】 手続補正書 2000050002 【整理番号】 平成16年 1月15日 【提出日】 特許庁長官殿 【あて先】 【事件の表示】 特願2003-71028 【出願番号】 【補正をする者】 【識別番号】 000005821 松下電器產業株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 【識別番号】 100105647 【弁理士】 小栗 昌平 【氏名又は名称】 【電話番号】 03-5561-3990 【手続補正1】 【補正対象書類名】 特許願 発明者 【補正対象項目名】 【補正方法】 変更 【補正の内容】 【発明者】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【住所又は居所】 佐々木 雄一朗 【氏名】 【発明者】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【住所又は居所】 水野 文二 【氏名】 【発明者】 大阪府茨木市美穂が丘10-1大阪大学内 【住所又は居所】 畑中 吉治 【氏名】 【発明者】

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】 片山 武司

【発明者】

【住所又は居所】

【住所又は居所】

【氏名】

所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内 渡邉 環

【その他】

私共、代理人は松下電器産業株式会社からの依頼により平成15年3月14日付で出願いたしました。その際、願書を作成するにあたり、発明者を「佐々木 雄一郎、水野 文二、畑中 吉治、片山 武司、渡邉 環」と記載すべきところ、発明者「渡邊 環」の文字を「渡辺 環」と誤って記載してしまいました。よって、当該手続補正書に正しい発明者「佐々木 雄一郎、水野 文二、畑中 吉治、片山 武司、渡邉 環」に訂正させて頂きたく、お願いする次第であります。

【書類名】

頁名】 手続補正書 理番号】 2000050002

【整理番号】 2000050002 【提出日】 平成16年 2月 9日

【あて先】 【事件の表示】

【出願番号】

特願2003-71028

特許庁長官殿

【補正をする者】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100105647

【弁理士】

【氏名又は名称】 小栗 昌平 【電話番号】 03-5561-3990

【手続補正1】

【補正対象書類名】 手続補正書

【補正対象項目名】 その他 【補正方法】 変更

【補正の内容】 【その他】

私共、代理人は松下電器産業株式会社からの依頼により平成15年3月14日付で出願いたしました。その際、願書を作成するにあたり、発明者を「佐々木 雄一朗、水野 文二、畑中 吉治、片山 武司、渡邉 環」と記載すべきところ、発明者「渡邊 環」の文字を「渡辺 環」と誤って記載してしまいました。よって、当該手続補正書に正しい発明者「佐々木 雄一朗、水野 文二、畑中 吉治、片山 武司、渡邉 環」に訂正させて頂きたく、お願いする次第であります。

【曹類名】

【整理番号】 【提出日】

【あて先】

【事件の表示】

【出願番号】

【補正をする者】

【識別番号】

【氏名又は名称】

【補正をする者】

【識別番号】 【氏名又は名称】

【代理人】

【識別番号】

【弁理士】 【氏名又は名称】

【電話番号】

【手続補正1】

【補正対象書類名】

【補正対象項目名】

【補正方法】

【補正の内容】

【その他】

手続補正書 2000050002

平成16年 2月13日

特許庁長官殿

特願2003-71028

000005821

松下電器産業株式会社

000006792

理化学研究所

100105647

小栗 昌平

03-5561-3990

手続補正書

その他

変更

私共、代理人は松下電器産業株式会社からの依頼により平成15年3月14日付で出願いたしました。その際、願書を作成するにあたり、発明者を「佐々木 雄一朗、水野 文二、畑中 吉治、片山 武司、渡邉 環」と記載すべきところ、発明者「渡邉 環」の文字を「渡辺 環」と誤って記載してしまいました。よって、当該手続補正書に正しい発明者「佐々木 雄一朗、水野 文二、畑中 吉治、片山 武司、渡邉 環」に訂正させて頂きたく、お願いする次第であります。

特願2003-071028

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住所

大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名

松下電器産業株式会社

特願2003-071028

出願人履歴情報

識別番号

[000006792]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1990年 8月28日 新規登録 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所



特願2003-071028

出願人履歴情報

識別番号

[503359821]

1. 変更年月日 [変更理由]

() 世田」住 所氏 名

2003年10月 1日

新規登録

埼玉県和光市広沢2番1号 独立行政法人理化学研究所